

# 物理電子システム創造専攻 平成18年度 博士中間（構想）発表会プログラム

資料

2006年6月20日版

会場：大学会館集会室 2

2006.7.6

(物電：発表15分,質疑15分 / 旧電シ：発表15分,質疑5分)

開始時間	研究室		名前	題名
9:10	石原研	D3	電シ 田淵良志明	Pt/(Bi, Nd)4Ti3O12/HfO2/Siゲート構造のMFIS-FETを用いた1T型FeRAMに関する研究
9:30	石原研	D2	中間 井端雅一	カーボンナノチューブを用いた強誘電体ゲートFETの研究
10:00	石原研	D1	構想 谷口幸夫	エキシマレーザによる光強度分布制御技術の研究
10:30				
10:50	徳光研	D3	電シ 斎木博和	強誘電体ゲートFETの集積化に関する研究
11:10	筒井研	D3	電シ 渡邊聡	弗化物共鳴トンネルダイオードを混載したシリコン集積回路に関する研究
11:30	伊藤研	D2	構想 柏木宏之	高フラックス冷却原子ビーム生成のための微小開口エバネッセント光ファネルの開発
12:00				
13:00	宗片研	D2	構想 早藤潤人	p-n ヘテロ接合におけるスピン起電力の研究
13:30	小山研	D2	構想 須田悟史	垂直共振器構造による光ネットワークデバイスに関する研究
14:00	小山研	D1	構想 増田浩次	基幹光通信システムのための広帯域・低雑音光ファイバ増幅技術の研究
14:30	小山研	D1	構想 長谷部浩一	面発光レーザ構造を用いた偏光制御素子に関する研究
15:00				
15:20	岩井・筒井研	D3	電シ 佐々木雄一郎	A study of B2H6 plasma doping for ultra shallow junctions
15:40	岩井研	D2	構想 ヘンドリアンシャーサウッディン	Improvement of Electrical Quality of Ultra Shallow Junctions Formed by B2H6 Plasma Doping
16:10	岩井研	D2	構想 下村 浩	RF-CMOS研究に関する博士論文の構成について
16:40	益研	D1	構想 小田典明	Si-UlSI対応高性能多層配線インテグレーション及び最適設計手法に関する研究